

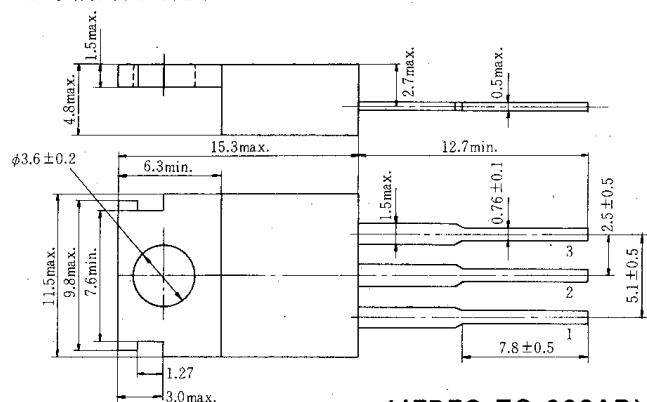
2SD976, 2SD976A

シリコン NPN 三重拡散形

電力スイッチング用
TV 水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

POWER SWITCHING
TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



(JEDEC TO-220AB)

1. ベース: Base
2. コレクタ: Collector
(フランジ) (Flange)
3. エミッタ: Emitter
(Dimensions in mm)

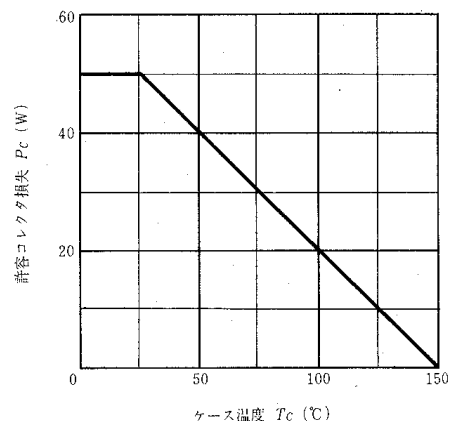
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SD976	2SD976A	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}		300	350	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}		120	150	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}			6	V
コレクタ電流	I_C			7	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$			10	A
サージコレクタ電流	$I_{C(\text{surge})}$			20	A
許容コレクタ損失	P_C^*			50	W
接合部温度	T_j			150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}			-45~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	2SD976			2SD976A			Unit
				min	typ	max	min	typ	max	
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$		$I_C=100\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	120	—	—	150	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$		$I_E=10\text{mA}$, $I_C=0$	6	—	—	6	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}		$V_{CB}=300\text{V}$, $I_E=0$	—	—	5	—	—	—	mA
			$V_{CB}=350\text{V}$, $I_E=0$	—	—	—	—	—	5	
直流電流増幅率	h_{FE}		$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=5\text{A}$	25	—	—	25	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$		$I_C=5\text{A}$, $I_B=0.5\text{A}$	—	—	2.0	—	—	1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(\text{sat})}$			—	—	1.2	—	—	1.2	V
下降時間	t_f		$I_{CP}=3.5\text{A}$, $I_{B1}=0.45\text{A}$	—	—	0.5	—	—	0.5	μs